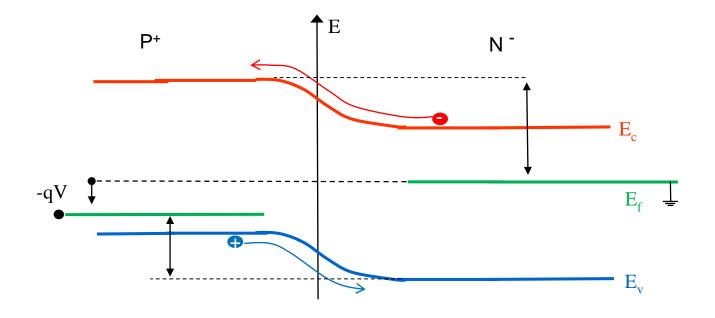


Exercice E6.1: diode p⁺/n⁻, passante



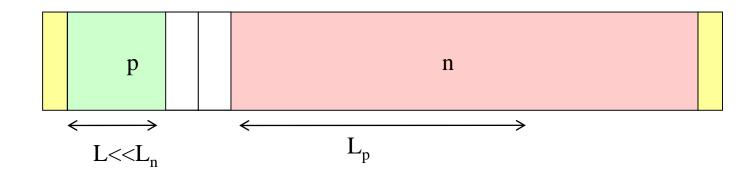


En mode passant, le courant dans la jonction est-il dominé par des électrons ou par des trous ?



Exercice E6.2: jonctions courtes





Les courants de diffusion des minoritaires sont obtenus en calculant le gradient des concentrations de minoritaires.

Celles-ci sont calculées en résolvant les équations de continuité avec deux conditions aux bords.

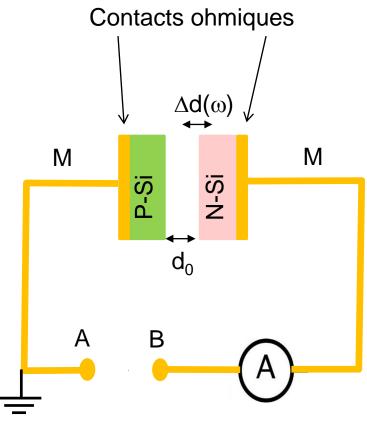
Supposons que ces deux conditions ne varient pas.

-Que se passe-il si la zone P devient nettement plus courte que la longueur de diffusion des électrons Ln ?



Exercice E6.3: Tension de built-in





$$\phi_m = \chi_s + \frac{E_g}{2}$$

- 1) Lorsque les plaques de silicium se touchent $(d_0=0)$:
 - Esquissez le schéma de bande
 - Quelle est la tension au point B?
- 2) Les points A et B sont court-circuités.
 - Esquissez le schéma de bande pour $d_0 > 0$
 - Comment varient la tension et les charges à l'interface P-Si/N-Si en fonction de la distance d₀ ?
- 3) La distance d_0 est fixée et on ajoute une petite variation Δd à fréquence ω .
 - Montrez qu'un courant apparait à fréquence ω, les points A et B étant toujours court-circuités.
- 4) Une tension –V_{bi} est imposée au point B.
 - Esquissez le schéma de bande.
 - Montrez que le courant disparait, la variation $\Delta d(\omega)$ étant toujours appliquée.